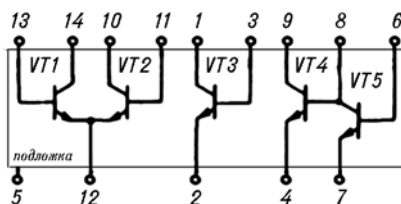


КР198НТ9

Микросхема представляет собой матрицу *n-p-n*-транзисторов. Содержит 5 интегральных элементов. Корпус типа 201.14-1, масса не более 1 г.



Электрическая схема КР198НТ9

Назначение выводов

1	коллектор VT3
2	эмиттер VT3
3	база VT3
4	эмиттер VT4
5	подложка
6	база VT5
7	эмиттер VT5
8	коллектор VT5 (база VT4)
9	коллектор VT4
10	коллектор VT2
11	база VT2
12	эмиттеры VT1 и VT2
13	база VT1
14	коллектор VT1

На вывод 5 подается отрицательное напряжение на 2,5 В ниже, чем на эмиттеры.

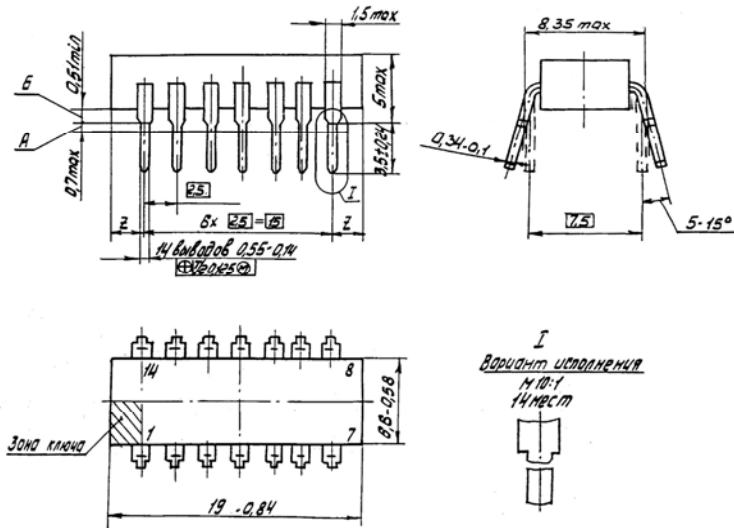
Электрические параметры

Напряжение насыщения база-эмиттер.....	≤1 В
Напряжение насыщения коллектор-эмиттер.....	≤0,7 В
Напряжение насыщения нуля дифференциальной пары.....	≤4 мВ
Обратный ток коллектора.....	≤40 нА
Статический коэффициент передачи тока.....	60...150
Разброс коэффициента передачи тока дифференциальной пары.....	≤15%

Предельно допустимые режимы эксплуатации

Напряжение коллектор-база.....	20 В
Напряжение эмиттер-база.....	5 В
Ток коллектора.....	10 мА
Рассеиваемая мощность одним транзистором.....	20 мВт
Импульсная рассеиваемая мощность матрицы.....	0,3 Вт
Температура окружающей среды.....	-45...+85°C

Чертеж корпуса
Пластмассовый корпус типа 201.14-1



1. А - длина выводов, в пределах которой производится контроль смещения плоскостей симметрии выводов от номинального расположения.
2. Б - ширина зоны, которая включает действительную ширину микросхемы и часть выводов, непригодную для контакта. Допускаются наплывы стекла по выводам за пределы наружного контура корпуса микросхемы не более 0,5 мм на сторону.
3. Допускаются заусенцы высотой 0,04 max, сверх размера 0,18 - 0,07
4. Нумерация выводов показана условно.
5. Дно металлическое.